

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԱՉԳԵՆ ԱՍՐՅԱՆ ՎԱՉԱԳԱՆԻ» ԱԶ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
3	Միաբյուրեղ MoSe2: Բյուրեղի չափսը՝ առնվազն 10 մմ: Տարրական բջջի չափսերը՝ $a = b = 0.329 \text{ nm}$, $c = 1.289 \text{ nm}$, $\alpha = \beta = 90^\circ$, $\gamma = 120^\circ$: Բյուրեղական ցանցի կառուցվածքը՝ վեցանկյուն (hexagonal): Մաքրությունը գերազանցի 99.995 % (»99.995 %): p-տիպի կիսահաղորդիչ: Լիցքակիրների խտությունը սենյակային ջերմաստիճանում՝ առնվազն $\sim 10^{15} \text{ cm}^{-3}$: Լինենն արտադրողի կողմից ներկայացված չափումներ, որոնք կհաստատեն բյուրեղի իսկությունը (XRD, Raman, EDX, Hall measurement):

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП «Вазген Вачаганович Асрян» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУЧЛ-БЦХЦНЗР-25/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	Монокристаллическая Мозе2. Размер кристалла: не менее 10 мм. Размеры элементарной ячейки: $a = b = 0,329$ Нм, $c = 1,289$ Нм, $\alpha = \beta = 90^\circ$, $\gamma = 120^\circ$. Структура кристаллической решетки: шестиугольная (гексагональная). чистота превышает 99,995 % (»99,995%). полупроводник р-типа. Плотность носителей заряда при комнатной температуре: не менее $\sim 10^{15}$ см ⁻³ . Должны быть представлены измерения, представленные производителем, которые подтвердят подлинность кристалла (XRD, Raman, EDX, измерение Холла).